

KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU,
LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY,
MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL,
PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK,
SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA,
UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告 (条約第21条(3))

of 80 mm or more. The raw material gas (G1) is introduced into the reaction furnace (10) in a manner that the number of gas exchange representing the introduction amount of the raw material gas (G1) into the reaction furnace (10) with respect to the volume of the reaction furnace (10), in a growth start period (T1) of the polysilicon rod (S1) until one hour passes from the start of precipitation of the polysilicon to the surface of the silicon core wire, is not less than 8 times but less than 35 times.

(57) 要約: 成長期間の初期のポリシリコンロッドの倒壊を防ぎつつ、成長期間の初期に析出されたポリシリコンロッドの比抵抗値を改善する。ポリシリコンロッド (S1) の製造方法は、反応炉 (10) の内部に立設され、通電加熱されてなるシリコン芯線にクロロシラン類を含む原料ガス (G1) を供給することにより、前記シリコン芯線の表面にポリシリコンを析出させ、直径が80mm以上のポリシリコンロッド (S1) として成長させるポリシリコンロッド (S1) の製造方法であって、前記シリコン芯線の表面へのポリシリコンの析出開始から1時間が経過するまでの、ポリシリコンロッド (S1) の成長開始期間 (T1) における、反応炉 (10) の体積に対する反応炉 (10) への原料ガス (G1) の投入量であるガス交換回数が、8回以上35回未満となるように、原料ガス (G1) を反応炉 (10) に投入する。